



理工学専攻電気電子工学コース大学院生が 日本表面真空学会九州支部学術講演会で学生講演奨励賞を受賞

【概要】

理工学専攻電気電子工学コース修士課程2年 Muhamad Mustofa さんが、令和4年6月11日(土)に佐賀大学本庄キャンパスで開催された2022年度日本表面真空学会九州支部学術講演会(九州表面・真空研究会2022)にて学生講演奨励賞を受賞しました。

【本文】

日本表面真空学会九州支部では、毎年、九州・沖縄・山口の大学や企業で活躍する研究者による学術講演会(兼九州表面・真空研究会)を開催し、薄膜・表面における種々の新奇な現象とその応用について幅広い議論がなされています。今年で27回目となる2022年度の本学術講演会が、令和4年6月11日(土)に佐賀大学本庄キャンパスにて開催されました。

当日は、半導体表面、金属表面、有機分子薄膜、結晶成長、プラズマ応用薄膜成長、放射光分析、炭素系新材料、ナノ材料などを対象とした24件の口頭発表があり、厳正な審査のもと、優秀な研究発表を行った5名の学生に対して学生講演奨励賞が授与されました。

理工学専攻電気電子工学コース修士課程2年 Muhamad Mustofa さんは、「MBE growth and characterization of Phosphorus-doped ZnTe Thin films」(燐ドーピングテルル化亜鉛薄膜の分子線エピタキシャル成長と評価)の講演題目で、太陽電池応用が期待されるテルル化亜鉛薄膜の分子線エピタキシャル成長において、原料の交互供給が燐ドーピングに効果的であることを明らかにした研究成果を発表し、学生講演奨励賞を受賞しました。

○学生講演奨励賞(日本表面真空学会九州支部学術講演会(九州表面・真空研究会2022))

電気電子工学コース修士課程2年 Muhamad Mustofa さん(指導教員:田中 徹 教授)

題目: MBE growth and characterization of Phosphorus-doped ZnTe Thin films

(燐ドーピングテルル化亜鉛薄膜の分子線エピタキシャル成長と評価)

発表者: Muhamad Mustofa, Katsuhiko Saito, Qixin Guo, Tooru Tanaka

参考: [学術講演会および受賞者リストのページ](#)



受賞した Mustofa さん